(19) Japanese Patent Office

(12) Official Gazette (A)

(11) Publication Number: Sho 63–86412
 (43) Date of Publication: April 16, 1988

(51) Int. Cl. H01G 4/18

Request for Examination: Not yet submitted

Number of Invention: 1 (4 pages)

(21) Application Number: Sho 61-232834

(22) Date of Filing: September 29, 1986

(71) Applicant: Unitika, LTD.

[Translation of Address Omitted]

(72) Inventors: Yasumitsu WATANABE

Masakazu KITANO

Kazutaka OKA

Mitsuhiro YAMASHITA Hirokazu YAMAMOTO

[Translation of Address Omitted]

(54) [Title] Method for Producing the Thin-Film Dielectric Material for Capacitor

[Page 51 left col. line 5 - right col. line 4]

# 2. Claim

A method for producing a thin-film dielectric material for capacitor comprising forming a conductive metal layer as a lower electrode on at least one surface of an organic polymer film as a support substrate in a longitudinal direction with a required design so that a non-evaporated portion exists, forming an organic polymer thin-film layer on the lower electrode according to a required pattern with a desired width so that a non-printed portion remains in a central part of the lower electrode, then forming a thin-film dielectric layer on the organic polymer thin-film layer

with a width narrower than the organic polymer thin-film layer, and furthermore, forming an upper electrode on a portion except an exposed portion of the lower electrode according to a required pattern with a desired width.

wherein the lower electrode, the thin-film dielectric layer and the upper electrode are formed by using an evaporation method, an ion plating method or a sputtering method, patterns of the thin-film dielectric layer and the upper electrode are formed by using an oil margin method, and the organic polymer thin-film layer is formed by using a coating method or a printing method.

# [Page 52 top left col. line 2 – top right col. line 9]

A conventional film capacitor uses an organic polymer film itself as a dielectric, thus having a low dielectric constant of about 2 to 5. In addition, the film thickness can be reduced only down to about 2  $\mu$  m due to a technical problem. Therefore, in order to achieve a large capacitance, it is necessary to laminate a number of layers.

Also, a capacitor that is produced by applying an organic polymer on the top portion of a conductive material has been developed recently. However, reducing the thickness of the applied film to  $1\,\mu$  m or less causes a problem concerning electric insulation.

On the other hand, an inorganic material has a dielectric constant higher than that of the organic polymer. However, it is difficult to be made into a thin-film. Consequently, it has a disadvantage in that larger capacitance is not possible in spite of the high dielectric constant. In

addition, such steps as applying and burning lead to higher processing cost.

In order to solve the conventional disadvantages mentioned above, it is an object of the present invention to produce a capacitor having a thin dielectric film layer, a larger dielectric constant and good electric insulation.

(Summary of the Invention)

The inventors have made earnest efforts to develop an industrially profitable method for producing the thin-film dielectric material for capacitor, thereby leading to the method according to the present invention including laminating a conductive metal layer as a lower electrode, an organic polymer thin-film layer, a thin-film dielectric layer and a conductive metal layer as an upper electrode in this order on at least one surface of an organic polymer film as a support substrate according to a required pattern of respective layers.

\* \* \* \* \*

# @ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63-86412

(1) Int Cl. 4

證別記号

庁内整理番号

④公開 昭和63年(1988) 4月16日

H 01 G 4/18

G-6751-5E 審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

コンデンサ用薄膜誘電体材料の製造方法 ⇔発明の名称

> 頤 昭61-232834 の特

					②11特 图	頁 昭	61-232834					
②出 顋 昭61(1986) 9月29日												
⑫発	明	者	渡	辺	康	光	京都府字治市字治小桜23番地	ユニチカ株式会社中央研究				
(G)C	נעפ	13	W.	~			所内					
砂発	明	者	北	野	Œ	和	京都府字治市字治小桜23番地	ユニチカ株式会社中央研究				
<b>Ω</b> 7%	明	者	岡		和	貴	所内 京都府字治市字治小桜23番地	ユニチカ株式会社中央研究				
⑪発	993	<b>49</b>	lm3		1,2		所内	- tal IN A A L. b TITPM				
⑫発	明	者	Щ	下	満	弘	京都府宇治市宇治小桜23番地	ユニチカ株式会社中央研究				
⑫発	明	者	山	本	博		所内 京都府宇治市宇治小桜23番地	ユニチカ株式会社中央研究				
<b>075</b>							所内	#2.1e1.				
லை	頤	人	ュ	ニチ	カ株式会	会社	兵庫県尼崎市東本町1丁目50	<b>登</b> 地				

#### 新田 明

## 1. 発明の名称

コンデンサ用薄膜誘電体材料の製造方法

### 2.特許請求の範囲

有機高分子フィルムを支持体基板とし、その 少なくとも一方の面に下部電極としての導電性 金属層を、高分子フィルムの長手方向に、必要 な設計で非蒸着部分が存在するように電極形成 し、その上に、有機高分子薄膜層を下部電極中 央部分に非印刷部分が残るように、任意の幅で、 必要なパターンに応じて形成し、さらに、 薄膜 誘電体層を有機高分子薄膜層より狭い幅で有機 高分子薄膜層上に形成し、さらにその上に、上 部電極を下部電極露出部を除いた部分に、任意 の幅で、必要なパターンに応じて形成してなる コンデンサ用薄膜誘電体材料を製造するに際し て、下部電極、薄膜誘電体層、及び上部電極の 形成に蒸着法,イオンプレーティング法あるい はスパツタリング法を用い、薄膜誘電体層及び

上部電極のパターン形成にオイル マージン法 を用い、有機高分子薄膜層の形成にコート法あ るいは印刷法を用いることを特徴とするコンデ ンサ用薄膜誘電体材料の製造方法。

# 3.発明の詳細な説明

# (産業上の利用分野)

本発明は、コンデンサ用薄膜誘電体材料の製造 方法に関するものであり、産業上、有益に、小型 ・軽量化フィルムコンデンサを大量生産すること を目的とする。

(従来の技術)(発明が解決しようとする問題点) 半導体技術の急速な進歩により、あらゆる産業 界にマイクロエレクトロニクス化の波が急ピツチ で浸透してきている。その中にあって、コンデン サもまた例外ではない。

コンデンサの節電容量は、誘電体の誘電率と電 極面積に比例し、電極間距離に反比例する。従っ て,コンデンサの小型化の基本は,誘電体を薄く, 誘電率を高くすることであり、フイルムコンデン サの小型化はプラスチツクフィルム成型技術に依

存するところが大きい。

従来のフィルムコンデンサは、有機高分子フィルム自身を誘電体として用いているため、誘電率は2~5程度で低く、また、フィルム厚みを薄くするにも、技術的問題より2μm程度が限度であると考えられる。従って、静電容量を大きくするには何層にも多層巻きをしなければならなかった。また、最近では導電体上部に有機高分子を塗布して製造するコンデンサも開発されているが、塗布して製造するコンデンサも開発されているが、塗布して製造するコンデンサも開発されているが、塗布して製造することでは減速するとはでは、電気記録性などに問題が生じてくる。

一方、無機材料は有機高分子に比べて誘電率が高いが、薄いフィルム状にすることが困難であるため、誘電率の割りに静電容量が大きくとれない欠点があり、また、塗布、焼成などの工程を経るため、加工費が高くつく。

そこで、本発明は従来のこのような欠点を解決 するため、誘電体膜厚が薄く、誘電率が大きく、 かつ絶縁性のよいコンデンサを製造することを目 的としている。

ーティング法あるいはスパツタリング法で成膜する(第2図)。その際、フィルムの長手方向に、必要な設計で下部電極を成膜するために、オイルマージン法、水溶性 マージン法、テープ マージン法あるいは蒸着マスク法を用いる。

この下部電極(2)上に、必要な電極(3)上に、必要な電極(3)とれぞれの商高分子薄膜層として、任意の分が残るので、有機高分子薄膜層として、自動を形成する(第3団と、高電性のので、1 k Hz でののでは、1 k Hz では、1 k Hz では、1 k Hz では、1 k Hz では、1 k Hz がの、1 k Hz がの、1 k Hz がの、2 k Hz がの、2 k Hz がのでは、1 k Hz がのでは、1 k Hz がののでは、1 k Hz がのには、1 k Hz がのでは、1 k Hz

(問題点を解決するための手段)

本発明者らは、前記コンデンサ用薄膜誘電体材料の産業上、有益な製造方法を開発すべく鋭色研究を進めた結果、有機高分子フィルムを支持体を板とし、その少なくとも一方の面に下部電極としての導電性金属層。有機高分子薄膜層、薄膜線を層の必要パターンに応じて順次積層するという本発明に到達したのである。

以下に、図面を容別して本発明を具体的に説明 する。

まず、下部電極は、有機高分子フィルムの長手方向に、必要な設計で非蒸着部分が存在するように電極形成される。導電性金属層としては、アルミニウム、亜鉛、金等があげられ、好ましくはアルミニウムを用いるのがよい。ただし、フィルムの長手方向とはフィルムの巻き取り方向を意方向とは天力には長手方向に交差する方向をで映する。有機高分子フィルム基板(1)上に(第1図)、導電性金属層(2)を蒸着法、イオンプレ

エノール系、エポキシ系、不飽和ポリエステル系、アルキド系、ウレタン系等があげられる。 通常、好ましくはポリエステル系樹脂を用いるのがよいが、耐熱性を必要とする場合には、ポリアミド系、ポリィミド系、ポリスルホン系を用いるのがよい。有機高分子層の形成方法としては、どのような方法を用いてもよいが、コート法あるいは印刷法を用いるのが望ましい。

そして、その上に、上部電極としての導電性金 属層を蒸着法、イオンブレーティング法あるいは スパツタリング法を用いて成膜する(第5図)。 その際、下部電極露出部以外の部分に成腹するた めに、オイル マージンを用いてパターンを形成 する。また,より高い電気絶縁抵抗及び誘電特性 が望まれる場合には、必要に応じて、薄膜誘電体 層 (4) と上部電極 (5) との間に有機高分子薄 膜層を付加してもよい。

- その後、ブリンターにより切り出すことによっ て (6). コンデンサ用薄膜誘電体材料を得るの である(第6図)。これらを所望の容量単位を得 るため、任意の長さで切り出すことによって巻き 回し型コンデンサ、あるいは単位容量を切り出し. 積層することよってチツブ型コンデンサを得るの である。

以上,有機高分子フィルムを支持体基板とし. その少なくとも一方の面に、下部電極としての導 電性金属層,有機高分子薄膜層,薄膜誘電体層。 及び上部電極としての導電性金属層を順次積層し

高分子薄膜層 (3) として、それぞれの下部電極 中央部分に2㎜、そして、下部電極の非蒸着部分 中央部にも2mの幅で非印刷部分が残るように. フィルムの長手方向にグラビア印刷法によりポリ エステル樹脂 (パイロン200,東洋紡) を0.3 μ m 形成した (第3図)。次いで、この非印刷部 分の両端を1 mm ずつ隠し、有機高分子層上に成膜 できるような形になるように、オイル マージン を用いて硫化亜鉛薄膜誘電体層 (4) をRFイオ ンプレーティング法により形成した(第4図)。 すなわち、アルゴンをベルジャー内に導入し、真 空度 7 × 1 0 - \*Torrに保ち、電圧 2 k V . 間波数 13.5 6 M Hz の高周波電界を 1 0 0 W 印加しなか ら、電子銃により硫化亜鉛蒸発母材を加熱蒸発さ せ. 0.5 μ m 形成した。ただし、蒸発母材は純度 99.99%の微粉末をプレス成型し、800℃で 6時間真空境箱を行ったものを用いた。そして。 この上に、下部電極露出部 2 페 と、その両端 1 페 ずつ、計 4 mを隠すように、オイル マージンを 用いて上部電極 (5) としてAlを0.06μm真

てなるコンデンサ用薄膜誘電体材料を製造するに 際して、薄膜誘電体層、上部電極各層のパターン 形成にオイル マージン法を用いることにより. 連続大量生産が可能となり、産業上、有益であり、 かつ歩留りのよい製造が可能となったのである。 (実施例)

以下に実施例を示して、本発明を図面を参照し て具体的に説明する。

# 実施例1~5

<del>- 表待伴基板(1)として、)(1)はあずのの。</del>-ポリエステルフイルムを用い(第1図),このフ イルムの幅方向に、18mのピッチ、幅4mのパ ターンで、水溶性高分子層として、ヒドロキシブ ロピルセルロース (TCI-E. P.. 東京化成) をフィルムの長手方向にグラビア印刷法により 1 μ m 形成した。次に、この上全面に、Α 1 を下部 電極 (2) として、真空蒸着法により0.06μm 蒸着し、水洗により水溶性高分子層ならびに水溶 性高分子層上のA1を同時に洗い出し、連続乾燥 炉にて水分を蒸発させた(第2図)。次に、有機

空蒸着した(第5図)。次に、スリツターにより、 それぞれの下部電極中央部及び下部電極間中央部 分を切断し(6)、巻き取り、コンデンサ用薄膜 誘電体材料を得た。

このコンデンサ用篠膜誘電体材料を素子巻機に かけて、設計静電容量20mF(実施例1)、40 n F (実施例 2), 60 n F (実施例 3), 80 n F (実施例 4). 1 0 0 n F (実施例 5)コンデンサ素 子を形成した。これらのコンデンサ素子に、亜鉛 溶射により外部電極を形成し、樹脂モールド後、 静電容量(1 k hzで測定)、電気絶縁抵抗 (3 0 V で測定)及び歩留り率を測定した。その結果を表 1. に示す。ただし、歩留り率はそれぞれサンプ ル100点を作成し、その内で電気絶縁抵抗が5 ×10 ° Q以上のものを百分率で表したものである。

0180 CT				
計解電容量 (nF)	実測師電容量 (nF)	<b>透理正接</b>	電気絶縁抵抗(10°口)	歩智り事
	20. 5	0.61	4.5	100
	41.0	0.62	2 2	100
		0.65	16	100
		0.66	1 2	100
	<del> </del>	0.70	9	100
	20 40 60 80	2 0 20. 5 4 0 41. 0 6 0 61. 2 8 0 82. 3	2 0 20. 5 0.61 4 0 41. 0 0.62 6 0 61. 2 0.65 8 0 82. 3 0.66	20     20.5     0.61     45       40     41.0     0.62     22       60     61.2     0.65     16       80     82.3     0.66     12

### (発明の効果)

本発明によれば、次の効果を得ることができる。

- (i) 従来の金属化フィルムコンデンサと比較して、大幅に小型化されたコンデンサ用薄膜誘電体材料を、産業上、安価に製造できる。
- (2) 従来の薄膜コンデンサと比較して、電気絶縁抵抗の大きい、誘電正接の小さなコンデン サ用薄膜誘電体材料を、歩留りよく製造できる。

<u>つまり、オイル・マージン法を用いることによ</u>り、従来の方法に比べて工程が簡略化され、大幅

り、従来の方法に比べて工程が簡略化され、大幅なコストダウンが可能となった。また同時に、誘電正接が低く、電気絶縁抵抗、歩留り率の高、本ののを安定して製造することが可能となった。本発明により製造された薄膜誘電体材料である金属化フィルムに比べて、製造加工工程上の取り扱いはほとんど変わらず、コンデンサ用の全く新規な優れた複膜誘電体材料を、産業上、有益に製造することができる。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図~第5図は、本発明の一例の態様を示す 断面図である。

- 1 有機高分子フィルム基板
- 2 下部電極
- 3 有機高分子薄膜層
- 4 薄膜誘電体層
- 5 上部電極
- 6 切断位置

、 特許出願人 ユニチカ株式会社

